



## 1 主要用途与主要特点

### 1.1 主要用途

用 W1XT309P 封装的成品管主要用于 USB、笔记本等电子设备的静电防护。

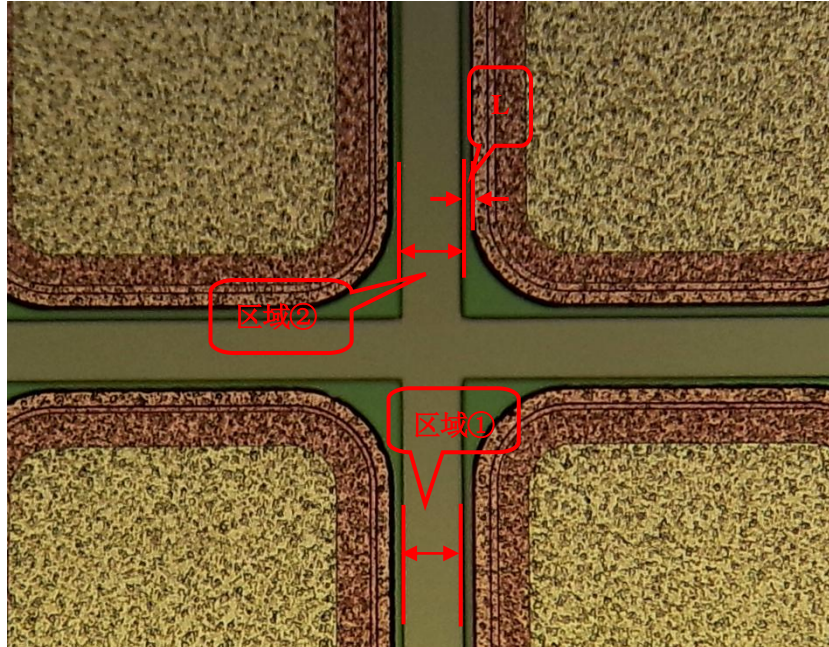
### 1.2 主要特点

- 低反向漏电
- 高静电防护能力
- 高可靠性

## 2 芯片数据

	芯片尺寸 (mm×mm)		0.28×0.28		
	芯片厚度 (μm) (推荐)		≤170		
	划片道*尺寸 (μm)		40		
	键合区面积 (μm <sup>2</sup> )	正面	150×150		
		金属	铝		
	正面电极 (阴极)	厚度 (μm)	5.0±1.0		
		背面电极 (阳极) (推荐)	表层金属	金	银
	装片要求 (推荐)		共晶	低温共晶	
	硅片直径 (mm)		φ125		
	键合要求 (推荐)		铜丝; φ32 μm; 一根		

\* 划片道位置示意图:



备注: 区域①为划片刀走刀区域, 划片时应在两条参考线中间; 区域②为划片道区域, 宽度为 40μm; 划片时划片道边缘到铝的距离 L 不小于 5μm 即判定为合格。

	<b>江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片</b> <b>W1XT309P</b>	文件编号	临时
	<b>瞬态电压抑制 (TVS) 二极管</b>	版本号	18-A1-08
		页码	2/2

### 3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

#### 3.1 极限值

除非另有规定,  $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位	备注
结温	$T_j$	150	$^{\circ}\text{C}$	推荐封装形式: SOD-523 推荐成品: WS36M2T
贮存温度	$T_{stg}$	-40~150	$^{\circ}\text{C}$	

#### 3.2 电参数

除非另有规定,  $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
击穿电压	$V_{BR}$	$I_Z=1\text{mA}$	40	43	48	V
反向电流	$I_R$	$V_R=36\text{V}$	—	—	1	$\mu\text{A}$
正向电压	$V_F$	$I_F=10\text{mA}$	—	—	0.9	V
钳位电压	$V_C$	$I_{PP}=2\text{A}(8\times 20\mu\text{s waveform})$	—	—	80	V
结电容	$C_{tot}$	$V_R=0\text{V}, f=1\text{MHz}$	—	20	—	pF

#### 3.3 典型特性曲线

暂无

#### 注意事项:

- 芯片存储条件(推荐): 氮气保护, 温度  $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ , 湿度  $\leq 45\%$ ;
- 本产品说明书仅供参考, 不作为合同的一部分, 具体以双方签订的技术协议为准;
- 本产品说明书如有版本变更, 恕不另行告知! 客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新;
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能, 买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施, 以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

### 江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: <http://www.xs-elec.com>

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532